垂直磁化 FePt | Ni₈₁Fe₁₉ ナノドットにおける 磁気渦ダイナミクスを介した磁化反転

関剛斎****、周偉男*、今村裕志***、荒井礼子*****、高梨弘毅* (*東北大金研、**JST さきがけ、***産総研スピントロニクス、)

Vortex dynamics-mediated magnetization switching in perpendicularly magnetized FePt | Ni₈₁Fe₁₉ nanodots

T. Seki*.**, W. Zhou*, H. Imamura***, H. Arai**.** and K. Takanashi*

(*IMR, Tohoku Univ., **JST-PRESTO, ***AIST)

<u>はじめに</u>

磁気記録の超高密度化のキーテクノロジーとして、静磁場以外の外部エネルギーを磁性体に加えることで 反転磁場を低減するエネルギーアシスト磁化反転が注目を集めている。高周波磁場を利用するマイクロ波ア シスト磁化反転は、磁化がエネルギー障壁を乗り越えて反転するための駆動力として磁化歳差運動を共鳴励 起し、小さな静磁場で磁化反転を誘起する手法である¹⁻³⁾。この手法は、多値記録において選択的に反転磁場 を低減できる利点がある一方、FePt 規則合金に代表される高磁気異方性材料ではサブ THz に達する高周波磁 場を必要とする問題がある。我々はこれまで、面内磁化 FePt 層と Ni₈₁Fe₁₉層から成る交換結合膜において、 Ni₈₁Fe₁₉層内にスピン波を励起することにより FePt 層の反転磁場を大幅に低減できることを報告してきた⁴⁾。 このスピン波アシスト磁化反転では、スピン波共鳴の周波数が動作周波数を決めるため、高磁気異方性材料 を用いた場合でも動作周波数の増大が原理的に生じない。これは交換結合膜を用いることの重要な利点であ る。本研究では、磁化配置をこれまでの面内磁化から応用に適用し易い垂直磁化配置へと変化させ、垂直磁 化を有する FePt | Ni₈₁Fe₁₉交換結合膜のナノドットにおいて磁化ダイナミクスが反転磁場へ与える影響につい て調べ、交換結合膜におけるアシスト磁化反転の有用性を検討した。

実験および数値計算

MgO(001)単結晶基板上に、Fe (1 nm) | Au (60 nm) | FePt (10 nm) | Ni₈₁Fe₁₉ (150 nm) | Au (5 nm) | Pt (3 nm)の積 層構造を作製した。まず、超高真空対応マグネトロンスパッタリング装置を用いて Fe (100)面、Au (100)面お よび FePt (100)面をエピタキシャル成長させ、その後、イオンビームスパッタ装置を用いて Ni₈₁Fe₁₉ 層および Au | Pt キャップ層を成膜した。FePt 層の成膜温度は 550 ℃ とし、L1₀構造への規則化を促進した。電子線リ ソグラフィーおよび Ar イオンミリングを用いて薄膜試料を直径 260 nm の円形ドットへと微細加工した。

垂直磁場下においてナノドットの磁化曲線を測定した結果、マイナーループに特徴的な挙動が観測された。 FePt 層のスイッチング磁場(H_{sw})以下では Ni₈₁Fe₁₉層の磁化反転は可逆的であり、FePt 層と Ni₈₁Fe₁₉層が界面 で交換結合していることが確認された⁵⁾。実験で得られた磁化曲線とマイクロマグネティクスによる数値計 算との比較したところ、FePt 層が垂直磁化を保持したまま、Ni₈₁Fe₁₉層内ではボルテックス磁気構造が形成さ れることが明らかとなった。また、垂直磁場を増大させるにつれて、ボルテックス磁気構造が界面付近に圧 縮され、Ni₈₁Fe₁₉層内の磁化が垂直方向へと揃うことがわかった。

この垂直磁化 FePt | Ni₈₁Fe₁₉ ナノドットに対し、外部から高周波磁場(H_{rf})を印加して、FePt の H_{sw} を評価した。 $H_{rf} = 0$ Oe では $H_{sw} = 8.6$ kOe であったが、11 GHz の $H_{rf} = 200$ Oe を印加することにより 2.8 kO まで H_{sw} が低減した。数値計算を用いて磁化反転時の詳細な磁気構造を調べたところ、Ni₈₁Fe₁₉層内のボルテックスの運動を介して FePt 層内に逆磁区が効果的に核生成され、その逆磁区が伝搬することによって磁化反転が進行していることが示された。

参考文献

1) J.-G. Zhu *et al.*, *IEEE Trans. Magn.* **44**, 125 (2008). 2) Y. Nozaki *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **95**, 082505 (2009). 3) S. Okamoto *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 237209 (2012). 4) T. Seki *et al.*, *Nat. Commun.* **4**, 1726 (2013). 5) W. Zhou *et al.*, *J. Appl. Phys.* **117**, 013905 (2015).